智能温度传感器 DS18B20

・赵海兰・

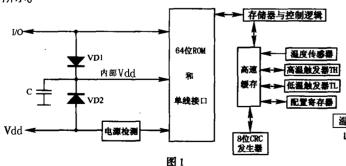
DS18B20 是美国 DALLAS 半导体公司继 DS1820 之后最新推出的一种改进型智能温度传感器。与传统的热敏电阻相比,它能够直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现9~12位的数字值读数方式。可以分别在93.75ms和750ms内完成9位和12位的数字量,而且从 DS18B20读出的信息或写入DS18B20的信息仅需要一根口线(单线接口)读写,温度变换功率来源于数据总线,总线本身也可以向所挂接的DS18B20供电,而无需额外电源。因而使用 DS18B20可使系统结构更趋简单,可靠性更高。它在测温精度、转换时间、传输距离、分辨率等方面较 DS1820有了很大的改进,给用户带来了更方便的使用和更令人满意的效果。

性能特点

1.独特的单线接口方式,DS18B20 与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20 的双向通讯。2.在使用中不需要任何外围元件。3.可用数据线供电,电压范围为3.0~5.5V。4.测温范围为-55~+125℃。固有测温分辨率为0.5℃。5.通过编程可实现9~12 位的数字读数方式。6.用户可自设定非易失性的报警上下限值。7.支持多点组网功能,多个DS18B20 可以并联在唯一的三线上,实现多点测温。8.负压特性,电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作。

内部结构

DS18B20 采用 3 脚 PR-35 封装或 8 脚 SOIC 封装, 其内部结构框图如图 1 所示。其中 64 位闪速 ROM 的结构如图 2 所示。



开始8位是产品类型的编号,接着是每个器件的唯一的序

号,共有48位,最后8位是前56位的 CRC 校验码,

8bit 检验	CRC	48bit	序列号	8bit工厂	代码(10H)			
MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSB			
图 2								

这也是多个 DS18B20 可以采用一线进行通信的原因。非易失性温度报警触发器TH和TL,可通过软件写入用户报警上下限。DS18B20温度传感器的内部存储器包括一个高速占存RAM和一个非易失性的可电擦除的EERAM,后者用于存储TH、TL值。数据先写入 RAM, 经校验后再传给 EERAM。而配置寄存器为高速存储器中的第5个字节,它的内容用于确定温度值的数字转换分辨率,DS18B20 工作时按此寄存器中的分辨率将温度转换为相应精度的数 TM R1 R0 1 1 1 1 1 1 值。该字节各位的定义 图3

如图3所示。低5位一直

都是1,TM是测试模式位,用于设置DS18B20在工作模式还

是在测试模式。在 DS18B20出厂时该位被设置为0,用户不要去改动,R1和R0决定温度转换的精度位数,即用来设置分辨率,如表1所示。

			表 7
R1	RO	分辨率	温度最大转换时间
0	0	9位	93.75ms
0	1	10位	187.5ms
1	0	11位	375 ms
1	1	12 位	750ms

由表可见,设定的分辨率越高,所需要的温度数据转换时间就越长。因此,在实际应用中要将分辨率和转换时间权 衡考虑。

高速暂存存储器除了配置寄存器外,还有其它8个字节组成,其分配如图 4 所示。其中温度信息(第 1、2 字节)、TH和TL值第 3、4 字节、第 6、7、8 字节未用,表现为全逻辑 1;第 9 字节读出的是前面所有 8 个字节的 CRC 码,可用来保证通信正确。

当 DS18B20 接收到温度转换命令后,开始启动转换。 转换完成后的温度值就以16位带符号扩展的二进制补码形 式存储在高速暂存存储器的第1、2字节。单片机可通过单

温度低位	温度高位	TH	TL.	配置	保留	保留	保留	8位CRC
LSB				图 4				MSB

线接□读到该数据,读取时低位在前,高位在后,数据格式以 0.0625 °C/LSB 形式表示。温度值格式如图 5 所示。

2 ³	2 ²	2 ¹	2 °	2-1	2-2	2-3	2-4
MSB							LSE
S	S	S	S	S	2 ⁶	2 ⁵	24
MSB	图 5					LSE	

当符号位 S=0 时, 直接将二进制位转换为 十进制; 当 S=1 时, 先 将补码变换为原码, 再 计算十进制值。表2是对

应的一部分温度值。

DS18B20完成 温度转换后,就把则 得的温度值与TH、 TL作比较,若T>TH 或T<TL,则将标志以 件内的告警标志出出 位,并对主机令作为 等搜索命,可用多

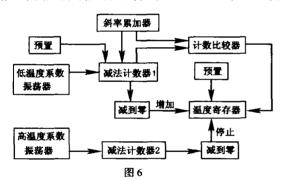
		表 2
温度/C	二进制表示	十六进制表示
+125	00000111 11010000	07D0H
+25.0625	00000001 10010001	0191H
+0.5	00000000 00001000	0008Н
+0	00000000 00000000	0000H
-0.5	11111111 11111000	FFF8H
-25.0625	11111110 01101111	FE6FH
-55	11111100 10010000	FC90H

只 DS18B20 同时测量温度并进行告警搜索。

在 64 位 ROM 的最高有效字节中存储有循环冗余校验码 (CRC)。主机根据 ROM 的前 56 位来计算 CRC 值,并和存入 DS18B20 中的 CRC 值作比较,以判断主机收到的 ROM 数据 是否正确。

測温原理

DS18B20 的测温原理如图 6 所示,图中低温度系数晶振的振荡频率受温度的影响很小,用于产生固定频率的脉冲信号



送给减法计数器 1,高温度系数晶振随温度变化其振荡频率明显改变,所产生的信号作为减法计数器 2 的脉冲输入,图中还隐含着计数门,当计数门打开时,DS18B20 就对低温度系数振荡器产生的时钟脉冲进行计数,进而完成温度测量。计数门的开启时间由高温度系数振荡器来决定,每次测量前,首先将-55℃所对应的基数分别置入减法计数器 1、温度寄存器中,减法计数器 1 和温度寄存器被预置在-55℃所对应的一个基数值。减法计数器 1 对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行减法计数器 1 的预置值减到 0 时,温度寄存器的值将加1,减法计数器 1 的预置值减到 0 时,温度寄存器的值将加1,减法计数器 1 的预置值减到 0 时,温度寄存器的值将加1,减法计数器 1 的预置值减到 0 时,温度寄存器的值将加1,减法计数器 1 的预置值率等存器值的累加,此时温度寄存器中的数值即为所测温度。图6中的斜率累加器用于补偿和修正测温过程中的非线性,其输出用于修正减法计数器的预置值,只要计数门仍未关闭就重复上述过程,直至温度寄

存器值达到被测温度值。

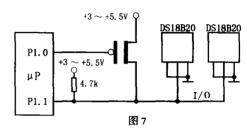
另外,由于DS18B20单线通信功能是分时完成的,它有严格的时隙概念,因此读写时序很重要。系统对DS18B20的各种操作必须按协议进行。操作协议为. 初始化DS18B20(发复位脉冲)→发ROM功能命令→发存储器操作命令→处理数据。各种操作的时序图与DS1820相同。

与单片机的接口电路

以 MCS-51 单片机为例,图 7 中采用寄生电源供电方式, P1.1 口接单线总线为保证在有效的 DS18B20 时钟周期内提供

足够的电流,可 用 一 个 MOSFET 管和 89C51 的 P1.0 来完成对总线的 上 拉 。 当 DS18B20 处于

写存储器操作和



温度 A/D 变换操作时,总线上必须有强的上拉,上拉开启时间最大为 10 µ s。采用寄生电源供电方式时 VDD和 GND 端均接地。由于单线制只有一根线,因此发送接收口必须是三态的。主机控制 DS18B20 完成温度转换必须经过初始化、ROM 操作指令、存储器操作指令三个步骤,假设单片机系统所用的晶振频率为 12MHz,根据 DS18B20 的初始化时序、写时序和读时序,分别编写 INIT 为初始化子程序,WRITE 为写(命令或数据)子程序,READ 为读数据子程序 3 个子程序,程序在本刊网上读取。所有的数据读写均由最低位开始。

使用注意事项

DS18B20虽然具有测温系统简单、测温精度高、连接方便、 占用口线少、扩展方便等优点,但在实际应用中应注意以下几 方面的问题:

- (1)较小的硬件开销需要相对复杂的软件进行补偿。由于 DS18B20与微处理器采用串行数据传送,因此,在对DS18B20 进行读写编程时必须严格地保证读写时序,否则将无法读取测 温结果。故对 DS1820 操作部分最好采用汇编语言编写。
- (2) DS18B20 工作时电流高达 1.5mA,总线上挂接点数较多且同时进行转换时要考虑增加总线驱动,可用单片机端口在温度转换时导通一个MOSFET。
- (3) 连接 DS18B20 的总线电缆是有长度限制的,因此在 用DS18B20进行长距离测温系统设计时要充分考虑总线分布电 容和阻抗匹配问题。
- (4)在DS18B20测温程序设计中,向DS18B20发出温度转换命令后,程序总要等待DS18B20的返回信号,一旦某个DS18B20接触不好或断线,当程序读该DS18B20时,将没有返回信号,程序进入死循环。这一点在进行DS18B20硬件连接和软件设计时也要给予一定的重视。
- (5)和DS1820一样, DS18B20的读写时序必须仔细调整, 在反复的调试中找出合适的延时时间。■